

开关二极管系列产品

2CK3595 型硅信号开关二极管

1 特性

芯片采用硅外延平面结构，器件为 D2-02A、D0-213AA 型玻璃封装。

具有反向电流小，体积小、重量轻，可靠性高的特点。

器件的静电放电敏感度为 3A 级，4000V。

D2-02A 典型重量 110mg，D0-213AA 典型重量 35mg。



D2-02A



D0-213AA

2 质量等级及执行标准

G 级：QZJ840611。

3 最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型号	V_{RWM} V	I_{FM} mA	I_{FSM} $t_p=8.3\text{ms}$, $T_A=25^{\circ}\text{C}$ mA	T_j $^{\circ}\text{C}$	T_{stg} $^{\circ}\text{C}$	$R_{\text{th}} (j-A)$ $^{\circ}\text{C}/\text{W}$
2CK3595	125	150	500	$-55\sim 175$	$-55\sim 175$	325

4 主要电特性

主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

序号	符号	测试条件	规范值
1	正向压降 V_{FM1}	$I_{\text{F}}=1\text{mA}$	$0.52\text{V}\sim 0.70\text{V}$
2	正向压降 V_{FM2}	$I_{\text{F}}=5\text{mA}$	$0.60\text{V}\sim 0.765\text{V}$
3	正向压降 V_{FM3}	$I_{\text{F}}=10\text{mA}$	$0.65\text{V}\sim 0.80\text{V}$
4	正向压降 V_{FM4}	$I_{\text{F}}=50\text{mA}$	$0.74\text{V}\sim 0.90\text{V}$
5	正向压降 V_{FM5}	$I_{\text{F}}=100\text{mA}$	$0.79\text{V}\sim 0.98\text{V}$
6	正向压降 V_{FM6}	$I_{\text{F}}=200\text{mA}$	$0.83\text{V}\sim 1.16\text{V}$
7	反向电流 I_{R1}	$V_{\text{R}}=125\text{V}$	$\leq 20\text{nA}$
8	反向电流 I_{R2} （用户需要时）	$T_A=150^{\circ}\text{C}$, $V_{\text{R}}=125\text{V}$	$\leq 10\text{ }\mu\text{A}$
9	反向击穿电压 V_{BR} （用户需要时）	$T_A=-55^{\circ}\text{C}$, $I_{\text{R}}=100\text{ }\mu\text{A}$	$\geq 150\text{V}$

注：D0-213AA 封装器件产品型号后增加“UR”标识。

7.1 引线成型

对于有引线封装产品，整体位置推荐距封装体 5mm 以上，至少 2mm。推荐弯曲弧度半径 R 为引线直径 T 的 2 到 3 倍。

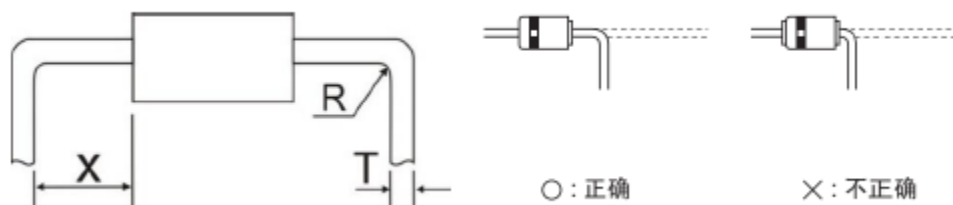


图 4 引线成型后示意图

8.2 产品焊接

焊接时推荐使用中性焊接剂，注意浸锡方式方法，手工焊接时，烙铁头温度宜为 280°C ，在任何情况下不应超过 330°C ；对于特殊场合，允许烙铁头温度为 360°C 。焊接时间为 $2\sim 3\text{s}$ 。再流焊区温度一般高于焊膏熔点 $20^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ ，再流焊时间为 $6\sim 10\text{s}$ ，再流焊温度可为 $210^{\circ}\text{C}\sim 230^{\circ}\text{C}$ ，最高不超过 235°C ；波峰焊焊接温度为 $250\pm 5^{\circ}\text{C}$ 。

8.3 涂敷防护

推荐使用喷涂方式进行三防漆的保型涂敷，玻璃封装产品注意玻璃体及玻璃体与印制板接触的部位不能有三防漆，也不能和周围的大器件桥连。如需进行粘固或固封等操作，请充分验证后进行。